

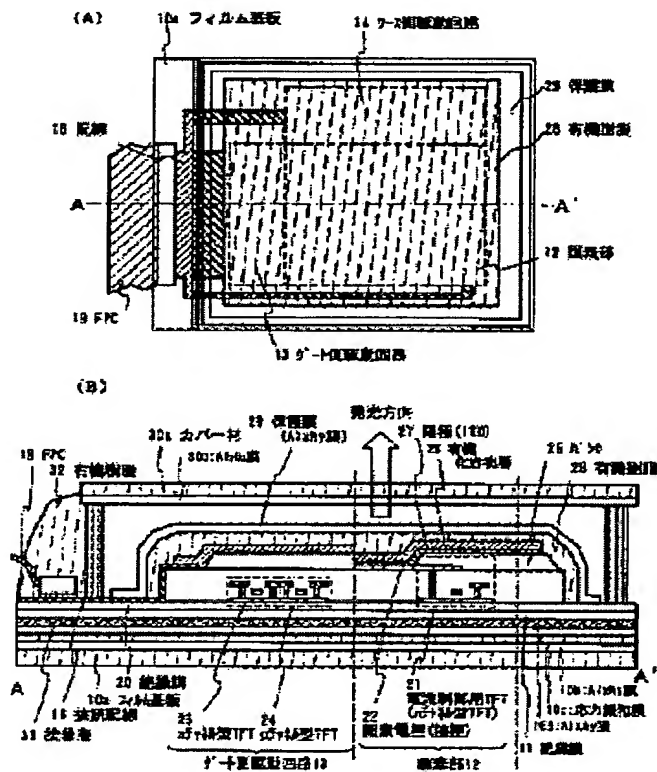
LIGHT EMITTING DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE

Patent number: JP2003086352
 Publication date: 2003-03-20
 Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI; TAKAYAMA TORU; KUWABARA HIDEAKI
 Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
 Classification:
 - international: G09F9/30; H05B33/02; H05B33/04; H05B33/14; G09F9/30; H05B33/02; H05B33/04; H05B33/14; (IPC1-7): H05B33/02; G09F9/30; H05B33/04; H05B33/14
 - european:
 Application number: JP20010273640 20010910
 Priority number(s): JP20010273640 20010910

Report a data error here

Abstract of JP2003086352

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a flexible light emitting device having an OLED formed on a plastic base board, enabled to restrain deterioration caused by the diffusion of impurities such as water, oxygen, alkali metal, alkali earth metal. SOLUTION: Not less than two layers of barrier film shown as AlXNY or Al2 O3 , preventing an organic light emitting layer of an OLED from the intrusion of oxygen and water, and preventing an active layer of TFT from the intrusion of alkali metal or alkali earth metal or the like, are formed, further, a stress releasing film containing resin is formed between the two layers of the barrier film.



REST AVAILABLE COPY

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2003-86352
(P2003-86352A)

(43) 公開日 平成15年3月20日 (2003.3.20)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
H 0 5 B 33/02		H 0 5 B 33/02	3 K 0 0 7
G 0 9 F 9/30	3 6 5	G 0 9 F 9/30	3 6 5 Z 5 C 0 9 4
H 0 5 B 33/04		H 0 5 B 33/04	
33/14		33/14	A

審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2001-273640 (P2001-273640)

(22) 出願日 平成13年9月10日 (2001.9.10)

(71) 出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所
神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 山崎 舜平

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 高山 徹

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

(72) 発明者 桑原 秀明

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

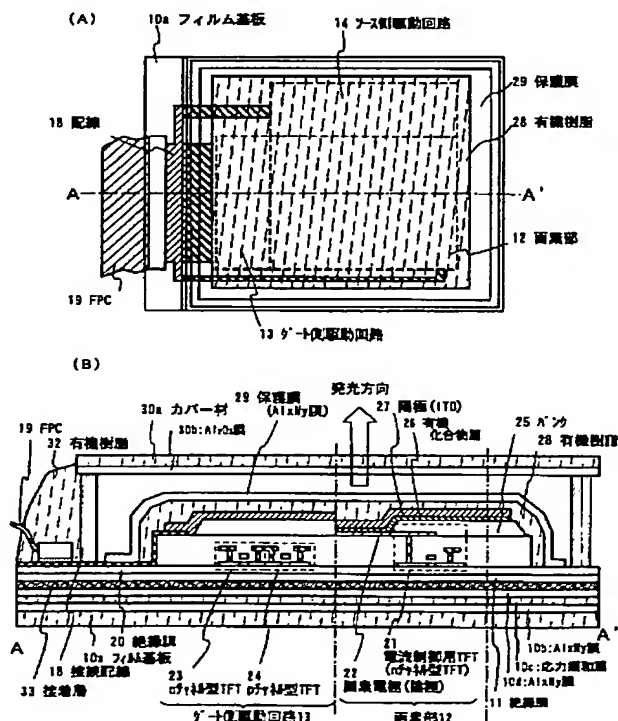
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 発光装置及び電子機器

(57) 【要約】

【課題】 水分や酸素やアルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物の拡散による劣化を抑えることが可能な発光装置、具体的には、プラスチック基板上に形成されたOLEDを有するフレキシブルな発光装置の提供を課題とする。

【解決手段】 プラスチック基板上に、酸素や水分がOLEDの有機発光層に入り込むのを防ぎ、且つアルカリ金属およびアルカリ土類金属などの不純物がTFTの活性層に入り込むのを防ぐことの可能な Al_xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層からなるバリア膜を2層以上設けて、さらに該2層のバリア膜の間に樹脂を含む応力緩和膜を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第 1 の基板と第 2 の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第 1 の基板には、 A_1XN_Y で示される層が設けられ、前記第 2 の基板には、 A_1O_3 で示される層が設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項 2】陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第 1 の基板と第 2 の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第 1 の基板には、 A_1XN_Y で示される層と有機樹脂からなる層との積層が設けられ、前記第 2 の基板には、 A_1O_3 で示される層が設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項 3】陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第 1 の基板と第 2 の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第 2 の基板には、前記発光素子との距離が近い順に A_1XN_Y で示される層と、該層に接して有機樹脂からなる層と、該層に接して A_1O_3 で示される層とが設けら

れていることを特徴とする発光装置。

【請求項 4】請求項 2 または請求項 3 において、前記有機樹脂からなる層は、 A_1XN_Y で示される層よりも応力が小さいことを特徴とする発光装置。

【請求項 5】請求項 1 乃至 4 のいずれか一において、前記有機樹脂からなる層は、前記基板を接着する接着層を含むことを特徴とする発光装置。

【請求項 6】陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第 1 の基板と第 2 の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第 2 の基板には、前記発光素子との距離が近い順に A_1XN_Y で示される層と、該層に接し、且つ該層よりも膜厚の厚い A_1O_3 で示される層との積層が設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項 7】陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第 1 の基板と第 2 の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第 2 の基板には、 A_1XN_Y で示される層が設けられ、該層は、前記発光素子との距離が遠ざかるにつれて窒素濃度が低減する濃度勾配を有することを特徴とする発光装置。

【請求項 8】請求項 1 乃至 7 のいずれか一において、前記発光素子は、 A_1XN_Y で示される層で包まれていることを特徴とする発光装置。

【請求項 9】請求項 1 乃至 8 のいずれか一において、前記 A_1XN_Y で示される層中の不純物である酸素は、0～10atm%未満であることを特徴とする発光装置。

【請求項 10】請求項 1 乃至 9 のいずれか一において、前記 A_1O_3 で示される層中の不純物である窒素は、0～2.5atm%未満であることを特徴とする発光装置。

【請求項 11】請求項 1 乃至 10 のいずれか一において、前記 A_1XN_Y で示される層は、周期律 13 族元素または周期律 15 族元素の不純物を 0.1atm%～5atm%含むことを特徴とする発光装置。

【請求項 12】請求項 1 乃至 10 のいずれか一において、前記 A_1XN_Y で示される層は、リン元素または硼元素を 0.1atm%～5atm%含むことを特徴とする発光装置。

【請求項 13】請求項 1 乃至 12 のいずれか一において、前記発光素子からの発光は、前記第 2 の基板を通過させて使用者に認識させることを特徴とする発光装置。

【請求項 14】請求項 1 乃至 13 のいずれか一において、前記発光装置をビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、カーナビゲーション、パーソナルコンピュータまたは携帯情報端末に備えたことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】発光装置、特に、プラスチック基板上に形成された有機発光素子 (OLED: Organic Light Emitting Device) を有する発光装置に関する。また、該 OLED パネルにコントローラを含む IC 等を実装した、OLED モジュールに関する。なお本明細書において、OLED パネル及び OLED モジュールを共に発光装置と総称する。本発明はさらに、該発光装置を用いた電子機器に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜 (厚さ数～数百 nm 程度) を用いて薄膜トランジスタ (TFT) を構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタは IC や電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。

【0003】このような画像表示装置を利用したアプリケーションは様々なものが期待されているが、特に携帯機器への利用が注目されている。現在、ガラス基板や石英基板が多く使用されているが、割れやすく、重いという欠点がある。また、大量生産を行う上で、ガラス基板や石英基板は大型化が困難であり、不向きである。そのため、可撓性を有する基板、代表的にはフレキシブルなプラスチックフィルムの上に TFT 素子を形成することが試みられている。

【0004】しかしながら、プラスチックフィルムの耐熱性が低いためプロセスの最高温度を低くせざるを得ず、結果的にガラス基板上に形成する時ほど良好な電気特性の TFT を形成できないのが現状である。そのため、プラスチックフィルムを用いた高性能な発光素子は実現されていない。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】近年、自発光型素子と

してOLEDを有したアクティブマトリクス型発光装置（以下、単に発光装置と呼ぶ）の研究が活発化している。発光装置は有機発光装置（OLED: Organic EL Display）又は有機ライトエミッティングダイオード（OLED: Organic Light Emitting Diode）とも呼ばれている。

【0006】OLEDは自ら発光するため視認性が高く、液晶表示装置（LCD）で必要なバックライトが要らず薄型化に最適であると共に、視野角にも制限が無い。そのため、OLEDを用いた発光装置は、CRTやLCDに代わる表示装置として注目されている。

【0007】もし、プラスチックフィルム等の可撓性を有する基板の上に有機発光素子（OLED: Organic Light Emitting Device）が形成された発光装置を作製することができれば、厚みが薄く軽量であるということに加えて、曲面を有するディスプレイや、ショーウィンドウ等などにも用いることができる。よって、その用途は携帯機器のみに限られず、応用範囲は非常に広い。

【0008】しかし、プラスチックからなる基板は、一般的に水分や酸素を透過しやすく、有機発光層はこれらのものによって劣化が促進されるので、特に発光装置の寿命が短くなりやすい。そこで従来では、プラスチック基板とOLEDの間に窒化珪素や窒化酸化珪素などからなる絶縁膜を設け、水分や酸素の有機発光層への混入を防いでいた。しかしながら、窒化珪素や窒化酸化珪素などからなる絶縁膜では水分や酸素の有機発光層への混入を十分防止することは困難であった。

【0009】加えて、プラスチックフィルム等の基板は一般的に熱に弱く、窒化珪素や窒化酸化珪素などの絶縁膜の成膜温度を高くしすぎると、基板が変形しやすくなる。また、成膜温度が低すぎると膜質の低下につながり、水分や酸素の透過を十分防ぐことが難しくなる。

【0010】また、プラスチックフィルム等の基板の上に設けた素子を駆動する際、局所的に発熱が生じて基板の一部が変形、変質してしまうことも問題になっている。

【0011】さらに、水分や酸素の透過を防ぐために、窒化珪素や窒化酸化珪素などの絶縁膜の膜厚を厚くすると、応力が大きくなり、クラック（亀裂）が入りやすくなる。また、膜厚を厚くすると、基板が曲げられたときに膜にクラックが入りやすくなる。また、基板を剥離する際、被剥離層が曲げられ、被剥離層にクラックが入ることもある。

【0012】また、TF Tは、水分や酸素に加え、アルカリ金属（Li、Cs、Na等）やアルカリ土類金属（Ca、Mg等）や他の金属元素の不純物が活性層に拡散すると特性が変化しやすいく。

【0013】また、最終製品とした後においても、他の不純物、例えば人の汗や接続部品からの不純物が拡散し、有機発光層やTF Tの活性層に混入すると、変質や劣化が促進される恐れがある。

【0014】本発明は上記問題に鑑み、水分や酸素やアルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物の拡散による劣化を抑えることが可能な発光装置、具体的には、プラスチック基板上に形成されたOLEDを有する発光装置の提供を課題とする。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明は、プラスチック基板上に、酸素や水分がOLEDの有機発光層に入り込むのを防ぎ、且つアルカリ金属およびアルカリ土類金属などの不純物がTF Tの活性層に入り込むのを防ぐことの可能な A_1xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層（これらの層を以下、バリア膜と呼ぶ）を設ける。好ましくは、複数のバリア膜で挟んで酸素や水分がOLEDの有機発光層に入り込むのを防ぐ構成とする。また、これらのバリア膜が少なくとも1層設けられた基板を2枚用意し、それらで挟んでもよい。

【0016】本明細書で開示する発明の構成は、陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第1の基板と第2の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第1の基板には、 A_1xNy で示される層が設けられ、前記第2の基板には、 Al_2O_3 で示される層が設けられていることを特徴とする発光装置である。

【0017】なお、上記 A_1xNy で示される層中の不純物である酸素を、0～10atm%未満とすることによって、水分や酸素をブロッキングすることができる効果に加え、熱伝導性が高く放熱効果を有するという特徴を有している。加えて、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物がTF Tの活性層に入り込むのを防ぐことができる。

【0018】また、上記 Al_2O_3 で示される層中の不純物である窒素を、0～2.5atm%未満とすることによって、透光性が非常に高いという特徴を有している。加えて、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物がTF Tの活性層に入り込むのを防ぐことができる。

【0019】また、プラスチック基板上に、酸素や水分がOLEDの有機発光層に入り込むのを防ぐバリア膜と、前記バリア膜よりも応力の小さい有機樹脂からなる層（応力緩和膜）との積層を設けてもよく、本発明の他の構成は、陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第1の基板と第2の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第1の基板には、 A_1xNy で示される層と有機樹脂からなる層との積層が設けられ、前記第2の基板には、 Al_2O_3 で示される層が設けられていることを特徴とする発光装置である。

【0020】具体的には、 A_1xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層からなるバリア膜を2層以上設けて、さらに該2層のバリア膜の間に樹脂を含む応力緩和膜（以下、応力緩和膜と呼ぶ）を設ける。そして、該3

層以上の絶縁膜上にOLEDを形成して密封することにより、発光装置を形成する。

【0021】上記構成、即ち、バリア膜と応力緩和膜の積層により、よりフレキシブルになり、曲げたときのクラックを防ぐことができる。

【0022】本発明では、 Al_xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層からなる複数のバリア膜を積層することで、バリア膜にクラックが生じて、他のバリア膜で水分や酸素などの不純物が有機発光層に入り込むのを効果的に防ぐことができ、アルカリ金属などの不純物がTFTの活性層に入り込むのを効果的に防ぐことができる。

【0023】また、バリア膜に比べて応力が小さい応力緩和膜を、応力緩和膜の間に挟むことで、全体の応力を緩和することができる。よって、トータルのバリア膜の厚さは同じであっても、1層のみのバリア膜に比べて、応力緩和膜の間に挟んだバリア膜は、応力によるクラックが入りにくい。

【0024】また、本発明において、バリア膜と応力緩和膜の積層の組み合わせは、 Al_xNy で示される層（第1バリア膜）と、該層に接して有機樹脂からなる層と、該層に接して Al_xNy で示される層（第2バリア膜）との積層でもよいし、有機樹脂からなる層（第1応力緩和膜）と、該層に接して Al_xNy で示される層と、該層に接して有機樹脂からなる層（第2応力緩和膜）との積層でもよいし、 Al_xNy で示される層（第1バリア膜）と、該層に接して有機樹脂からなる層と、該層に接して Al_2O_3 で示される層（第2バリア膜）との積層でもよい。

【0025】また、熱伝導性が高く放熱効果を有する Al_xNy で示される層を前記発光素子との距離ができるだけ近い構成とすることが好ましく、本発明の他の構成は、陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第1の基板と第2の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第2の基板には、前記発光素子との距離が近い順に Al_xNy で示される層と、該層に接して有機樹脂からなる層と、該層に接して Al_2O_3 で示される層とが設けられていることを特徴とする発光装置である。

【0026】また、上記バリア膜は、 Al_xNy で示される層と Al_2O_3 で示される層との積層であってもよく、その場合、透光性が Al_xNy で示される層よりも高い Al_2O_3 で示される層の膜厚を厚くすることが好ましく、本発明の他の構成は、陰極と、該陰極に接する有機化合物層と、該有機化合物層に接する陽極とを有する発光素子を第1の基板と第2の基板との間に挟んだ発光装置であって、前記第2の基板には、前記発光素子との距離が近い順に Al_xNy で示される層と、該層に接し、且つ該層よりも膜厚の厚い Al_2O_3 で示される層との積層が設けられていることを特徴とする発光装置である。このよ

うにバリア膜を Al_xNy で示される層と、該層に接する Al_2O_3 で示される層との積層とした場合、トータルの膜厚を薄くすることができ、水分、酸素、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物をブロッキングすることができる効果に加え、熱伝導性が高く放熱効果を有し、さらには透光性が非常に高いという特徴を有している。

【0027】また、基板に設ける Al_xNy で示される層として前記発光素子との距離が近い側に窒素を多く含ませ、遠ざかるにつれて窒素が少なくなるような濃度勾配を持たせてもよい。このようにバリア膜を Al_xNy で示される層に窒素の濃度勾配を持たせた場合、トータルの膜厚を薄くすることができ、トータルの透光性を向上させることができる。

【0028】また、本発明において、前記発光素子からの発光をどちらか一方に通過させて出射させる場合には、透光性の高い Al_2O_3 で示される層が設けられている基板を通過させて使用者に認識させることが好ましい。

【0029】また、2枚の基板で挟む際には接着層で基板同士を接着することになるが、両基板にバリア膜を設けても、接着層を通過して水分や酸素などの不純物が侵入してくる恐れがある。そこで、上記発光素子を覆うパッシベーション膜（保護膜とも呼ぶ）として Al_xNy で示される層を用い、上記発光素子をバリア膜とパッシベーション膜とで包む構造とすることが好ましい。加えて、上記発光素子を覆って、 Al_xNy で示される層からなるパッシベーション膜を2層以上設けて、さらに該2層のパッシベーション膜の間に樹脂を含む応力緩和膜（以下、応力緩和膜と呼ぶ）を設けてもよい。パッシベーション膜に比べて応力が小さい応力緩和膜を、応力緩和膜の間に挟むことで、全体の応力を緩和することができる。

【0030】また、上記各構成において、前記有機樹脂からなる層は、 Al_xNy で示される層よりも応力が小さい材料、例えば、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、ベンゾシクロブテン、またはエポキシ樹脂から選ばれた単層、またはそれらの積層からなることを特徴としている。また、上記各構成において、前記有機樹脂からなる層は、前記基板を接着する接着層を含むことを特徴としている。

【0031】また、上記各構成において、前記基板は、可撓性を有するプラスチック基板であれば特に限定されないが、例えば、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエーテルスルホン（PES）、ポリエチレンナフタレート（PEN）、ポリカーボネート（PC）、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリスルホン（PSF）、ポリエーテルイミド（PEI）、ポリアリレート（PAR）、ポリブチレンテレフタレート（PBT）、ポリイミドから選ばれた1種また

は複数種からなるプラスチック基板である。

【0032】また、本発明の他の構成は、発光装置と外部との間に Al_xNy で示される層、 Al_2O_3 で示される層、または有機樹脂からなる層を単層または多層有していることを特徴とする電子機器である。

【0033】また、上記各構成において、前記 Al_xNy で示される層は、周期律 13 族元素または周期律 15 族元素の不純物を 0.1 atm% ~ 5 atm% 含むことを特徴としている。

【0034】また、上記各構成において、前記 Al_xNy で示される層は、リン元素またはボロン元素を 0.1 atm% ~ 5 atm% 含むことを特徴とする発光装置。

【0035】また、上記各構成における上記 Al_xNy で示される層により、素子の発熱を拡散させて素子の劣化を抑える効果とともに、プラスチック基板の変形や変質を保護する効果を有する。

【0036】なお、本明細書では、OLED の陽極と陰極の間に形成された全ての層を有機発光層と定義する。有機発光層には具体的に、発光層、正孔注入層、電子注入層、正孔輸送層、電子輸送層等が含まれる。基本的に OLED は、陽極／発光層／陰極が順に積層された構造を有しており、この構造に加えて、陽極／正孔注入層／発光層／陰極や、陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／陰極等の順に積層した構造を有していることもある。

【0037】また、OLED は、電場を加えることで発生するルミネッセンス (Electroluminescence) が得られる有機化合物 (有機発光材料) を含む層 (以下、有機発光層と記す) と、陽極と、陰極とを有している。有機化合物におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光 (蛍光) と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光 (リン光) とがあるが、本発明の発光装置は、上述した発光のうちの、いずれか一方の発光を用いていても良いし、または両方の発光を用いていても良い。

【0038】

【発明の実施の形態】本発明の実施形態について、以下に説明する。

【0039】図 1 (A) は、EL モジュールを示す上面図、図 1 (B) は図 1 (A) を A-A' で切断した断面図である。図 1 (B) において、表面にバリア膜として機能する Al_xNy で示される層 (Al_xNy 膜とも呼ぶ) 10b と、応力緩和膜 (有機樹脂) 10c と、 Al_xNy 膜 10d との積層が設けられた可撓性を有するフィルム基板 10a (例えば、プラスチック基板等) が接着層 33 で絶縁膜 11 と接着されている。なお、接着層 33 もバリア膜よりも応力の小さい材料を用いて応力緩和膜として機能させてもよい。このように、複数のバリア膜 10b、10d を積層することで、バリア膜にクラックが生じても、他のバリア膜で水分や酸素などの不純物が有

機発光層に入り込むのを効果的に防ぐことができる。加えて、複数のバリア膜の間に応力緩和膜を設けることによって、よりフレキシブルな発光装置になり、曲げたときのクラックを防ぐことができる。

【0040】また、膜厚 100 nm における Al_xNy 膜の透過率を図 12 に示す。図 12 に示すように、 Al_xNy 膜は透光性が高く (可視光領域で透過率 80% ~ 91.3%)、発光素子からの発光の妨げにならない。なお、 Al_xNy 膜は Al_2O_3 で示される層よりは透光性が低い。従って、ここでは、 Al_2O_3 で示される層を発光が通過するカバー材 30a に設けている。

【0041】本発明において、 Al_xNy 膜は、スパッタ法を用い、例えば、窒化アルミニウム (AlN) ターゲットを用い、アルゴンガスと窒素ガスを混合した雰囲気下にて成膜する。 Al_xNy 膜に含まれる不純物、特に酸素は 0 ~ 10 atm% 未満であればよく、スパッタ条件 (基板温度、原料ガスおよびその流量、成膜圧力など) を適宜調節することによって酸素濃度を調節することができる。なお、得られた Al_xNy 膜の ESCA (Electron Spectroscopy for Analysis) での分析による組成を図 13 に示す。また、アルミニウム (Al) ターゲットを用い、窒素ガスを含む雰囲気下にて成膜してもよい。なお、スパッタ法に限定されず、蒸着法やその他の公知技術を用いてもよい。

【0042】また、本発明において、バリア膜として Al_2O_3 で示される層を形成する場合、スパッタ法を用い、例えば、酸化アルミニウム (Al_2O_3) ターゲットを用い、アルゴン雰囲気下にて成膜する。非常に高い透光性を得るためには、 Al_2O_3 に含まれる不純物、特に窒素は、0 ~ 2.5 atm% 未満であればよく、スパッタ条件 (基板温度、原料ガスおよびその流量、成膜圧力など) を適宜調節することによって窒素濃度を調節することができる。また、アルミニウム (Al) ターゲットを用い、酸素ガスを含む雰囲気下にて成膜してもよい。なお、スパッタ法に限定されず、蒸着法やその他の公知技術を用いてもよい。

【0043】また、 Al_xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層でプラスチック基板の片面または両面のみを覆う構成としてもよい。

【0044】なお、ここでは耐熱性を有する基板上に絶縁膜 11、絶縁膜 20 を設け、その上に画素部 22、ソース側駆動回路 14、及びゲート側駆動回路 13 を設けた後、カバー材を接着して固定し、耐熱性を有する基板を剥離した後、上記フィルム基板を貼りつけているが、特に限定されず、画素部 22、ソース側駆動回路 14、及びゲート側駆動回路 13 の形成温度に耐え得るフィルム基板であれば、フィルム基板上に画素部 22、ソース側駆動回路 14、及びゲート側駆動回路 13 を形成すればよく、その場合、接着層を設ける必要はない。

【0045】耐熱性を有する基板 (ガラス基板や石英基

板)を剥離する技術は特に限定されず、ここでは、膜の内部応力を利用して剥離を行う剥離方法、具体的には、耐熱性を有する基板上に熱処理によって膜剥がれ(ピーリング)などのプロセス上の異常は生じない第1の材料層と第2の材料層との積層を設け、該積層上に素子(TFTや発光素子)を形成した後、物理的手段、代表的には機械的な力を加えること、例えば人間の手で引き剥がすことで容易に第2の材料層の層内または界面において、きれいに分離できる方法を用いる。第1の材料層と第2の材料層との結合力は、熱エネルギーには耐え得る強さを有している一方、剥離する直前において、引張応力を有する第1の材料層と圧縮応力を有する第2の材料層との間には応力歪みを有しているため、力学的エネルギーに弱く、剥離する。ここでは、第1の材料層としてタングステン膜を用い、第2の材料層としてスパッタ法による酸化珪素膜を用いて剥離させたため、絶縁膜11が第2の材料層に相当している。

【0046】また、耐熱性を有する基板を剥離する他の技術として、分離層を介して存在する被剥離層を前記基板から剥離する剥離方法(特開平10-125929号公報、特開平10-125931号公報)を用いてもよい。上記公報に記載の技術は、非晶質シリコン(またはポリシリコン)からなる分離層を設け、基板を通過させてレーザー光を照射して非晶質シリコンに含まれる水素を放出させることにより、空隙を生じさせて基板を分離させるというものである。

【0047】図1(B)において、絶縁膜20上には画素部12、ゲート側駆動回路13が形成されており、画素部12は電流制御用TFT21とそのドレインに電気的に接続された画素電極(陰極)22を含む複数の画素により形成される。電流制御用TFT21としてはpチャネル型TFTを用いることも可能であるが、nチャネル型TFTを用いることが好ましい。また、ゲート側駆動回路13はnチャネル型TFT23とpチャネル型TFT24とを組み合わせたCMOS回路を用いて形成される。各TFTの活性層としては、結晶構造を有する半導体膜(ポリシリコン膜)や非晶質構造を有する半導体膜(アモルファスシリコン膜など)を用いる。

【0048】また、画素電極22は発光素子(OLED)の陰極として機能する。また、画素電極22の両端にはバンク25が形成され、画素電極22上には有機化合物層26および発光素子の陽極27が形成される。

【0049】有機化合物層26としては、発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせて有機化合物層(発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層)を形成すれば良い。例えば、低分子系有機化合物材料や高分子系有機化合物材料を用いればよい。また、有機化合物層26として一重項励起により発光(蛍光)する発光材料(シングレット化合物)からなる薄膜、または三重項励起により発光(リン光)する発光材

料(トリプレット化合物)からなる薄膜を用いることができる。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これらの有機材料や無機材料は公知の材料を用いることができる。

【0050】陽極27は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線18を経由してFPC19に電気的に接続されている。さらに、画素部12及びゲート側駆動回路13に含まれる素子は全て陽極27、有機樹脂28、及び保護膜29で覆われている。

【0051】また、図1(A)において、28は有機樹脂、29は保護膜であり、画素部12および駆動回路13、14は有機樹脂28で覆われ、その有機樹脂は保護膜(Al_xNy 膜)29で覆われている。なお、有機樹脂28としては、できるだけ可視光に対して透明もしくは半透明な材料を用いるのが好ましい。また、有機樹脂28はできるだけ水分や酸素などの不純物を透過しない材料であることが望ましい。

【0052】さらに、画素部12および駆動回路13、14は、接着剤を用いてカバー材30aで封止されている。カバー材30aは、支持体として剥離前に接着される。なお、支持体となるカバー材30aを接着した後、剥離する際には配線引き出し端子の部分(接続部分)が絶縁膜20、11のみとなり機械強度が弱くなるため、剥離前にFPC19を貼りつけ、さらに有機樹脂32で固定している。

【0053】ここで、熱や外力などによる変形に耐えるためカバー材30aはフィルム基板10aと同じ材質のもの、例えばプラスチック基板を用いることが望ましい。なお、水分や酸素などの不純物の侵入を防ぐため、カバー材30aには予めバリア膜30bを形成する。ここではカバー材中を通して発光を通過させるため、単層のバリア層(Al_2O_3 膜30b)としたが、フィルム基板10aと同様に、複数のバリア膜と、該バリア膜どうしの間に前記バリア膜よりも応力の小さい層(応力緩和膜)を設けてもよい。その場合、バリア膜及び応力緩和膜としては透光性の高いものを用いる。

【0054】なお、18はソース側駆動回路14及びゲート側駆動回路13に入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるFPC(フレキシブルプリントサーキット)19からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基盤(PWB)が取り付けられていても良い。本明細書におけるELモジュールには、発光素子が設けられた基板本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

【0055】以上のような構造で発光素子を Al_xNy で示されるバリア膜10b、10d及び Al_xNy で示される保護膜29、 Al_2O_3 膜30bで封入することにより、発光素子を外気から完全に遮断することができ、装

置外から水分や酸素等による有機化合物層の酸化が主原因である劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。加えて、発光素子との距離が近い箇所に設けられた Al_xNy 膜により発熱を発散することができる。従って、信頼性の高い発光装置を得ることができる。

【0056】加えて、複数のバリア膜の間に応力緩和膜を設けることによって、外力が与えられても破壊することなく、フレキシブルな発光装置になる。

【0057】また、図2には、外力が与えられたフレキシブルな発光装置45の外観図を示した。図2中、40は画素部、41はFPC、42a、42bは集積回路、43a、43bはゲート側駆動回路、44はソース側駆動回路、45a、45bはフィルム基板である。フィルム基板45a及びフィルム基板45bには、 Al_xNy で示される層（または Al_2O_3 で示される層）と有機樹脂からなる層との積層が片面または両面に設けられており、外からの水分、酸素、アルカリ金属などの不純物が侵入してくるのを防ぎ、OLED及びTFTを保護している。

【0058】また、 Al_xNy で示される層（或いは Al_2O_3 で示される層）と有機樹脂からなる層との積層を基板の外側表面に設けた場合、発光装置と外部との間に Al_xNy で示される層（或いは Al_2O_3 で示される層）または有機樹脂からなる層を単層または多層有している構成となり、外部からの不純物拡散を防止することができる。本明細書中、外部とは、ELモジュールに外部接続される素子やICチップ、ELモジュールに接触するパッケージやその他の部材を含めた総称を指すこととする。

【0059】なお、フィルム基板45a上に画素部40や駆動回路や発光素子が設けられており、フィルム基板45bとでこれらの素子を挟みこんでいる。これらの画素部や駆動回路と同一基板上に複雑な集積回路（メモリ、CPU、コントローラ、D/Aコンバータ等）42a、42bを形成しても可能であるが、少ないマスク数での作製は困難である。従って、メモリ、CPU、コントローラ、D/Aコンバータ等を備えたICチップを、COG (chip on glass) 方式やTAB (tape automated bonding) 方式やワイヤボンディング方法で実装することが好ましい。フィルム基板45aとフィルム基板45bとを接着した後、ICチップを装着してもよいし、フィルム基板45aにICチップを装着した後でフィルム基板45bで封止してもよい。

【0060】なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基盤（PWB）が取り付けられていても良い。

【0061】また、画素電極を陽極とし、有機化合物層と陰極を積層して図1とは逆方向に発光する構成としてもよい。その場合には電流制御用TFTとしてpチャネル型TFTを用いることが好ましい。

【0062】以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこととする。

【0063】（実施例）

【実施例1】本発明の実施例を図3及び図4を用いて説明する。ここでは、まず、同一基板上にnチャネル型TFTとpチャネル型TFTとを相補的に組み合わせたCMOS回路を同時に作製する方法について詳細に説明する。

【0064】まず、基板100上に第1の材料層101、第2の材料層102、下地絶縁膜103を形成し、結晶構造を有する半導体膜を得た後、所望の形状にエッチング処理して島状に分離された半導体層104、105を形成する。

【0065】基板100としては、ガラス基板（#1737）を用いる。

【0066】また、第1の材料層101としては、成膜後或いは剥離直前において、 $1 \sim 1 \times 10^{10}$ (Dyne/cm²) の範囲で引張応力を有することを特徴としている。前記第1の材料層としては、上記範囲の引張応力を有する材料であれば、特に限定されず、金属材料（Ti、Al、Ta、W、Mo、Cu、Cr、Nd、Fe、Ni、Co、Zr、Zn、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Ptなど）、半導体材料（例えばSi、Geなど）、絶縁体材料、有機材料のいずれか一層、またはこれらの積層を用いることができる。なかでも、タングステン膜、窒化タングステン膜、窒化チタン膜が好ましい。なお、 $1 \sim 1 \times 10^{10}$ (Dyne/cm²) よりも大きな引張応力を有する膜は、熱処理を加えた場合、ピーリングを起しやすい。ここではスパッタ法で膜厚100nmの窒化チタン膜を用いる。なお、基板100と密着性が悪い場合にはバッファ層を設ければよい。

【0067】また、第2の材料層102としては、 $-1 \sim -1 \times 10^{10}$ (Dyne/cm²) の範囲で圧縮応力を有することを特徴としている。前記第2の材料層としては、上記範囲の圧縮応力を有する材料であれば、特に限定されず、金属材料（Ti、Al、Ta、W、Mo、Cu、Cr、Nd、Fe、Ni、Co、Zr、Zn、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Ptなど）、半導体材料（例えばSi、Geなど）、絶縁体材料、有機材料のいずれか一層、またはこれらの積層を用いることができる。なお、 -1×10^{10} (Dyne/cm²) よりも大きな圧縮応力を有する膜は、熱処理を加えた場合、ピーリングを起しやすい。中でも、酸化シリコン材料または酸化金属材料からなる単層、またはこれらの積層が好ましい。ここではスパッタ法で膜厚200nmの酸化シリコン膜を用いる。この第1の材料層101と第2の材料層102の結合力は熱処理には強く、膜剥がれ（ピーリングとも呼ばれる）などが生じないが、物理的手段で簡単に第2の材料層の層内、あるいは界面において剥離することができ

る。

【0068】また、下地絶縁膜103としては、プラズマCVD法で成膜温度400℃、原料ガスSiH₄、N₂Oから作製される酸化窒化シリコン膜（組成比Si=32%、O=27%、N=24%、H=17%）を50nm（好ましくは10～200nm）形成する。次いで、表面をオゾン水で洗浄した後、表面の酸化膜を希フッ酸（1/100希釈）で除去する。次いでプラズマCVD法で成膜温度400℃、原料ガスSiH₄、N₂Oから作製される酸化窒化シリコン膜（組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%）を100nm（好ましくは50～200nm）の厚さに積層形成し、さらに大気解放せずにプラズマCVD法で成膜温度300℃、成膜ガスSiH₄で非晶質構造を有する半導体膜（ここではアモルファスシリコン膜）を54nmの厚さ（好ましくは25～80nm）で形成する。

【0069】本実施例では下地膜103を2層構造として示したが、前記絶縁膜の単層膜または2層以上積層させた構造として形成しても良い。また、半導体膜の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム（Si_xGe_{1-x}（X=0.0001～0.02））合金などを用い、公知の手段（スパッタ法、LP CVD法、またはプラズマCVD法等）により形成すればよい。また、プラズマCVD装置は、枚葉式の装置でもよいし、バッチ式の装置でもよい。また、同一の成膜室で大気に触れることなく下地絶縁膜と半導体膜とを連続成膜してもよい。

【0070】次いで、非晶質構造を有する半導体膜の表面を洗浄した後、オゾン水で表面に約2nmの極薄い酸化膜を形成する。

【0071】次いで、重量換算で10ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をスピナーで塗布する。塗布に代えてスパッタ法でニッケル元素を全面に散布する方法を用いてもよい。

【0072】次いで、加熱処理を行い結晶化させて結晶構造を有する半導体膜を形成する。この加熱処理は、電気炉の熱処理または強光の照射を用いればよい。電気炉の熱処理で行う場合は、500℃～650℃で4～24時間で行えばよい。ここでは脱水素化のための熱処理（500℃、1時間）の後、結晶化のための熱処理（550℃、4時間）を行って結晶構造を有するシリコン膜を得る。なお、ここでは炉を用いた熱処理を用いて結晶化を行ったが、ランプアニール装置で結晶化を行ってもよい。なお、ここではシリコンの結晶化を助長する金属元素としてニッケルを用いた結晶化技術を用いたが、他の公知の結晶化技術、例えば固相成長法やレーザー結晶化法を用いてもよい。

【0073】次いで、結晶構造を有するシリコン膜表面の酸化膜を希フッ酸等で除去した後、結晶化率を高め、結晶粒内に残される欠陥を補修するための第1のレーザ

ー光（XeCl：波長308nm）の照射を大気中、または酸素雰囲気中で行う。レーザー光には波長400nm以下のエキシマレーザー光や、YAGレーザーやYVO₄レーザーの第2高調波、第3高調波を用いる。第1のレーザー光は、パルス発振であってもよいし、連続発振でもよい。パルス発振の場合、繰り返し周波数10～1000Hz程度のパルスレーザー光を用い、当該レーザー光を光学系にて100～500mJ/cm²に集光し、90～95%のオーバーラップ率をもって照射し、シリコン膜表面を走査させればよい。ここでは、繰り返し周波数30Hz、エネルギー密度393mJ/cm²で第1のレーザー光の照射を大気中で行なう。なお、大気中、または酸素雰囲気中で行うため、第1のレーザー光の照射により表面に酸化膜が形成される。

【0074】次いで、第1のレーザー光の照射により形成された酸化膜を希フッ酸で除去した後、第2のレーザー光の照射を窒素雰囲気、或いは真空中で行い、半導体膜表面を平坦化する。このレーザー光（第2のレーザー光）には波長400nm以下のエキシマレーザー光や、YAGレーザーの第2高調波、第3高調波を用いる。第2のレーザー光のエネルギー密度は、第1のレーザー光のエネルギー密度より大きくし、好ましくは30～60mJ/cm²大きくする。ここでは、繰り返し周波数30Hz、エネルギー密度453mJ/cm²で第2のレーザー光の照射を行ない、半導体膜表面における凹凸のP-V値（Peak to Valley、高さの最大値と最小値の差分）が50nm以下となる。このP-V値は、AFM（原子間力顕微鏡）により得られる。

【0075】また、本実施例では第2のレーザー光の照射を全面に行ったが、オフ電流の低減は、画素部のTF Tに特に効果があるため、少なくとも画素部のみに選択的に照射する工程としてもよい。

【0076】次いで、オゾン水で表面を120秒処理して合計1～5nmの酸化膜からなるバリア層を形成する。

【0077】次いで、バリア層上にスパッタ法にてゲッタリングサイトとなるアルゴン元素を含む非晶質シリコン膜を膜厚150nmで形成する。本実施例のスパッタ法による成膜条件は、成膜圧力を0.3Paとし、ガス（Ar）流量を50（sccm）とし、成膜パワーを3kWとし、基板温度を150℃とする。なお、上記条件での非晶質シリコン膜に含まれるアルゴン元素の原子濃度は、 $3 \times 10^{20} / \text{cm}^3 \sim 6 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ 、酸素の原子濃度は $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3 \sim 3 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ である。その後、ランプアニール装置を用いて650℃、3分の熱処理を行いゲッタリングする。

【0078】次いで、バリア層をエッチングストッパーとして、ゲッタリングサイトであるアルゴン元素を含む非晶質シリコン膜を選択的に除去した後、バリア層を希フッ酸で選択的に除去する。なお、ゲッタリングの際、

ニッケルは酸素濃度の高い領域に移動しやすい傾向があるため、酸化膜からなるバリア層をゲッタリング後に除去することが望ましい。ここではゲッタリングを行った例を示したが、特に限定されず、他のゲッタリング方法でもよい。

【0079】次いで、得られた結晶構造を有するシリコン膜（ポリシリコン膜とも呼ばれる）の表面にオゾン水で薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状にエッチング処理して島状に分離された半導体層 104、105 を形成する。半導体層を形成した後、レジストからなるマスクを除去する。

【0080】次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時にシリコン膜の表面を洗浄した後、ゲート絶縁膜 106 となる珪素を主成分とする絶縁膜を形成する。本実施例では、プラズマ CVD 法により 115 nm の厚さで酸化窒化シリコン膜（組成比 Si = 32 %、O = 59 %、N = 7 %、H = 2 %）で形成する。

【0081】次いで、図 3 (B) に示すように、ゲート絶縁膜 106 上に膜厚 20 ~ 100 nm の第 1 の導電膜 107 と、膜厚 100 ~ 400 nm の第 2 の導電膜 108 とを積層形成する。本実施例では、ゲート絶縁膜 106 上に膜厚 50 nm の窒化タンタル膜、膜厚 370 nm のタングステン膜を順次積層する。

【0082】第 1 の導電膜及び第 2 の導電膜を形成する導電性材料としては Ta、W、Ti、Mo、Al、Cu から選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料で形成する。また、第 1 の導電膜及び第 2 の導電膜としてリン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜や、AgPdCu 合金を用いてもよい。また、2 層構造に限定されず、例えば、膜厚 50 nm のタングステン膜、膜厚 500 nm のアルミニウムとシリコンの合金 (Al-Si) 膜、膜厚 30 nm の窒化チタン膜を順次積層した 3 層構造としてもよい。また、3 層構造とする場合、第 1 の導電膜のタングステンに代えて窒化タングステンをを用いてもよいし、第 2 の導電膜のアルミニウムとシリコンの合金 (Al-Si) 膜に代えてアルミニウムとチタンの合金膜 (Al-Ti) を用いてもよいし、第 3 の導電膜の窒化チタン膜に代えてチタン膜を用いてもよい。また、単層構造であってもよい。

【0083】次に、図 3 (C) に示すように光露光工程によりレジストからなるマスク 109 を形成し、ゲート電極及び配線を形成するための第 1 のエッチング処理を行う。エッチングには ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法を用いるとよい。ICP エッチング法を用い、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節することによって所望のテーパ形状に膜をエッチングすることができる。なお、エッチング用ガスとしては、Cl₂、

BCl₃、SiCl₄、CCl₄などを代表とする塩素系ガスまたは CF₄、SF₆、NF₃などを代表とするフッ素系ガス、または O₂ を適宜用いることができる。

【0084】第 1 のエッチング処理では、レジストによるマスクの形状と、基板側に印加するバイアス電圧の効果により端部をテーパ形状とすることができる。テーパ部の角度は 15 ~ 45° となるようにする。また、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10 ~ 20 % 程度の割合でエッチング時間を増加させるとよい。W 膜に対する酸化窒化シリコン膜の選択比は 2 ~ 4（代表的には 3）であるので、オーバーエッチング処理により、酸化窒化シリコン膜が露出した面は 20 ~ 50 nm 程度エッチングされる。こうして、第 1 のエッチング処理により第 1 導電膜と第 2 導電膜から成る第 1 形状の導電層 110、111（第 1 の導電層 110a、111a と第 2 導電層 110b、111b）を形成する。112 はゲート絶縁膜であり、第 1 の形状の導電層で覆われない領域は 20 ~ 50 nm 程度エッチングされ薄くなる。

【0085】そして、第 1 のドーピング処理を行い n 型の不純物（ドナー）をドーピングする。（図 3 (D)）その方法はイオンドープ法若しくはイオン注入法で行う。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ として行う。n 型を付与する不純物元素として 15 族に属する元素、典型的にはリン (P) または砒素 (As) を用いる。この場合、第 1 形状の導電層 110、111 はドーピングする元素に対してマスクとなり、加速電圧を適宜調節（例えば、20 ~ 60 keV）して、ゲート絶縁膜 112 を通過した不純物元素により不純物領域（n+領域）113、114 を形成する。例えば、不純物領域（n+領域）におけるリン (P) 濃度は $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ の範囲となるようにする。

【0086】次いで、図 4 (A) に示すように第 2 のドーピング処理を行う。第 1 のドーピング処理よりもドーズ量を下げ高加速電圧の条件で n 型の不純物（ドナー）をドーピングする。例えば、加速電圧を 70 ~ 120 keV とし、 $1 \times 10^{13} / \text{cm}^2$ のドーズ量で行い、図 3 (D) で半導体層に形成された第 1 の不純物領域の内側に不純物領域を形成する。ドーピングは、第 2 の導電膜 110b、111b を不純物元素に対するマスクとして用い、第 1 の導電膜 110a、111a の下側の領域に不純物元素が添加されるようにドーピングする。こうして、第 1 の導電膜 110a、111a と重なる不純物領域（n-領域）115、116 が形成される。この不純物領域は、第 2 の導電層 110a、111a がほぼ同じ膜厚で残存していることから、第 2 の導電層に沿った方向における濃度差は小さく、 $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ の濃度で形成する。

【0087】次いで、図 4 (B) に示すように第 2 のエ

ッチング処理を行う。エッチングはICPエッチング法を用い、エッチングガスに CF_4 と Cl_2 と O_2 を混合して、1 Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF電力(13.56MHz)を供給してプラズマを生成する。基板側(試料ステージ)には50WのRF(13.56MHz)電力を投入し、第1のエッチング処理に比べ低い自己バイアス電圧を印加する。このような条件によりタングステン膜を異方性エッチングし、第1の導電層である窒化タンタル膜またはチタン膜を残存させるようにする。こうして、第2形状の導電層117、118(第1の導電膜117a、118aと第2の導電膜117b、118b)を形成する。119はゲート絶縁膜であり、第2の形状の導電層117、118で覆われない領域はさらに20~50nm程度エッチングされて膜厚が薄くなる。

【0088】そして、図4(C)に示すように、レジストによるマスク120を形成し、pチャネル型TFTを形成する半導体層にp型の不純物(アクセプタ)をドーピングする。典型的にはボロン(B)を用いる。不純物領域(p+領域)121、122の不純物濃度は $2 \times 10^{20} \sim 2 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ となるようにし、含有するリン濃度の1.5~3倍のボロンを添加して導電型を反転させる。

【0089】以上までの工程でそれぞれの半導体層に不純物領域が形成される。第2形状の導電層117、118はゲート電極となる。その後、図4(D)に示すように、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜から成る保護絶縁膜123をプラズマCVD法で形成する。そして導電型の制御を目的としてそれぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化する工程を行う。

【0090】さらに、窒化シリコン膜124を形成し、水素化処理を行う。その結果、窒化シリコン膜124中の水素が半導体層中に拡散させることで水素化を達成することができる。

【0091】次いで、層間絶縁膜125を形成する。層間絶縁膜125は、ポリイミド、アクリルなどの有機絶縁物材料で形成する。勿論、プラズマCVD法で TEOS (Tetraethyl Ortho silicate)を用いて形成される酸化シリコン膜を適用しても良いが、平坦性を高める観点からは前記有機物材料を用いることが望ましい。

【0092】次いで、コンタクトホールを形成し、アルミニウム(Al)、チタン(Ti)、タンタル(Ta)などを用いて、ソース配線またはドレイン配線126~128を形成する。

【0093】以上の工程で、nチャネル型TFTとpチャネル型TFTとを相補的に組み合わせたCMOS回路を得ることができる。

【0094】pチャネル型TFTにはチャネル形成領域130、ソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域121、122を有している。

【0095】nチャネル型TFTにはチャネル形成領域131、第2形状の導電層から成るゲート電極118と重なる不純物領域116a(Gate Overlapped Drain: GOLD領域)、ゲート電極の外側に形成される不純物領域116b(LDD領域)とソース領域またはドレイン領域として機能する不純物領域119を有している。

【0096】このようなCMOS回路は、アクティブマトリクス型の発光装置やアクティブマトリクス型の液晶表示装置における駆動回路の一部を形成することを可能とする。それ以外にも、このようなnチャネル型TFTまたはpチャネル型TFTは、画素部のトランジスタに応用することができる。

【0097】このようなCMOS回路を組み合わせたことで基本論理回路を構成したり、さらに複雑なロジック回路(信号分割回路、D/Aコンバータ、オペアンプ、γ補正回路など)をも構成することができ、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成することが可能である。

【0098】[実施例2]ここでは、上記実施例1で得られるTFTを用いてOLEDを有する発光装置を作製した例について図5を用い、以下に説明する。

【0099】同一の絶縁体上に画素部とそれを駆動する駆動回路を有した発光装置の例(但し封止前の状態)を図5に示す。なお、駆動回路には基本単位となるCMOS回路を示し、画素部には一つの画素を示す。このCMOS回路は実施例1に従えば得ることができる。

【0100】図5において、200は基板、201は第1の材料層、202は第2の材料層であり、その素子形成基板上に設けられた下地絶縁層203上にはnチャネル型TFTとpチャネル型TFTからなる駆動回路204、pチャネル型TFTからなるスイッチングTFTおよびnチャネル型TFTからなる電流制御TFTとが形成されている。また、本実施例では、TFTはすべてトップゲート型TFTで形成されている。

【0101】nチャネル型TFTおよびpチャネル型TFTの説明は実施例1を参照すれば良いので省略する。また、スイッチングTFTはソース領域およびドレイン領域の間に二つのチャネル形成領域を有した構造(ダブルゲート構造)となっているpチャネル型TFTである。なお、本実施例はダブルゲート構造に限定されことなく、チャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは三つ形成されるトリプルゲート構造であっても良い。

【0102】また、電流制御TFTのドレイン領域206の上には第2層間絶縁膜208が設けられる前に、第1層間絶縁膜207にコンタクトホールが設けられている。これは第2層間絶縁膜208にコンタクトホールを形成する際に、エッチング工程を簡単にするためである。第2層間絶縁膜208にはドレイン領域206に到達するようにコンタクトホールが形成され、ドレイン領

域 206 に接続された画素電極 209 が設けられている。画素電極 209 は OLED の陰極として機能する電極であり、周期表の 1 族もしくは 2 族に属する元素を含む導電膜を用いて形成されている。本実施例では、リチウムとアルミニウムとの化合物からなる導電膜を用いる。

【0103】次に、213 は画素電極 209 の端部を覆うように設けられた絶縁膜であり、本明細書中ではバンクと呼ぶ。バンク 213 は珪素を含む絶縁膜もしくは樹脂膜で形成すれば良い。樹脂膜を用いる場合、樹脂膜の比抵抗が $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^{12} \Omega \text{m}$ (好ましくは $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10} \Omega \text{m}$) となるようにカーボン粒子もしくは金属粒子を添加すると、成膜時の絶縁破壊を抑えることができる。

【0104】また、OLED 210 は画素電極 (陰極) 209、有機化合物層 211 および陽極 212 からなる。陽極 212 は、仕事関数の大きい導電膜、代表的には酸化導電膜が用いられる。酸化導電膜としては、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛もしくはそれらの化合物を用いれば良い。

【0105】なお、本明細書中では発光層に対して正孔注入層、正孔輸送層、正孔阻止層、電子輸送層、電子注入層もしくは電子阻止層を組み合わせた積層した層の総称を有機化合物層と定義する。但し、有機化合物層には有機化合物膜を単層で用いた場合も含むものとする。

【0106】また、発光層としては、有機化合物材料であれば特に限定されないが、高分子材料や低分子材料を用いてもよく、例えば二重項励起により発光する発光材料からなる薄膜、あるいは三重項励起により発光する発光材料からなる薄膜を用いることができる。

【0107】なお、ここでは図示しないが陽極 212 を形成した後、OLED 210 を完全に覆うようにしてパッシベーション膜を設けることは有効である。パッシベーション膜としては、熱伝導性を有する膜、例えば、 Al_xN_y で示される層が適している。また、他のパッシベーション膜としては、さらに DLC 膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜を積層してもよく、これらを組み合わせた積層を用いてもよい。

【0108】次いで、OLED 210 を保護するため、実施の形態に示したように支持体となるカバー材を貼りつけて封止 (または封入) 工程まで行った後、第 1 の材料層 201 が設けられた基板 200 を引き剥がす。そして第 2 の材料層にフィルム基板を接着層で貼り合わせる。貼り合わせるフィルム基板には複数のバリア膜と、前記バリア膜どうしの間に前記バリア膜よりも応力の小さい層 (応力緩和膜) とが設けられており、貼り合わせた後の状態が、実施の形態 1 に示した図 1 (A)、図 1 (B) である。第 2 の材料層 202 が絶縁膜 11 に対応している。

【0109】[実施例 3] ここでは、実施例 2 に示した

工程とは異なる例を示し、具体的には剥離工程及び貼り合わせ工程についてさらに詳細な説明を図 6、図 7 を用いて説明する。

【0110】図 6 (A) 中、300 は基板、301 は窒化物層、302 は酸化層、303 は下地絶縁層、304a~304c は素子、305 は OLED、306 は層間絶縁膜である。

【0111】図 6 (A) において、基板 300 はガラス基板、石英基板、セラミック基板などを用いることができる。また、シリコン基板、金属基板またはステンレス基板を用いても良い。

【0112】まず、図 6 (A) に示すように、実施の形態に従って、基板 300 上に第 1 の材料層 301 と第 2 の材料層 302 とを形成する。この第 1 の材料層 301 の膜応力と、第 2 の材料層 302 の膜応力とを異ならせることが重要である。各々の膜厚は、 $1 \text{ nm} \sim 1000 \text{ nm}$ の範囲で適宜設定し、各々の膜応力を調節すればよい。

【0113】次いで、第 2 の材料層 302 上に被剥離層を形成する。被剥離層は、TFT を代表とする様々な素子 (薄膜ダイオード、シリコンの PIN 接合からなる光電変換素子やシリコン抵抗素子) を含む層とすればよい。また、基板 300 の耐え得る範囲の熱処理を行うことができる。なお、本発明において、第 2 の材料層 302 の膜応力と、第 1 の材料層 301 の膜応力が異なっても、被剥離層の作製工程における熱処理によって膜剥がれなどが生じない。ここでは、被剥離層として、下地絶縁層 303 上に、駆動回路 23 の素子 304a、304b、および画素部 304 の素子 304c を形成し、画素部 304 の素子 304c と電気的に接続する OLED 15 を形成し、OLED を覆うように膜厚 $10 \text{ nm} \sim 1000 \text{ nm}$ である層間絶縁膜 (透光性を有する有機樹脂) 306 を形成する。(図 1 (A))

【0114】また、第 1 の材料層 301 や第 2 の材料層 302 によって表面に凹凸が形成された場合、下地絶縁層を形成する前後に表面を平坦化してもよい。平坦化を行った方が、被剥離層においてカバレッジが良好となり、素子を含む被剥離層を形成する場合、素子特性が安定しやすいため好ましい。なお、この平坦化処理として、塗布膜 (レジスト膜等) を形成した後エッチングなどを行って平坦化するエッチバック法や機械的研磨法 (CMP 法) 等を用いればよい。

【0115】次いで、層間絶縁膜 306 上に膜厚 $10 \text{ nm} \sim 1000 \text{ nm}$ である Al_xN_y で示されるアルミニウムを含む窒化膜 307 を形成する。(図 6 (B)) なお、発光素子からの光を通過させる場合には、透光性を重視して膜厚を 200 nm 以下とすることが望ましい。この Al_xN_y 膜 307 は保護膜として機能する。ここでは、窒化アルミニウム (AlN) ターゲットを用い、アルゴンガス (20 sccm) と窒素ガス (20 scc)

m)とを混合した雰囲気下にて成膜する。また、アルミニウム (Al) ターゲットを用い、窒素ガスを含む雰囲気下にて成膜してもよい。また、 Al_xNy 膜 307は、装置外から水分や酸素などの不純物といったOLED15の劣化を促す物質が侵入することを防ぐ効果も有している。

【0116】次いで、FPC310やICチップ (図示しない) をCOG (chip on glass) 方式やTAB (tape automated bonding) 方式やワイヤボンディング方法で貼り付ける。また、各TFT素子の各配線と入出力端子311は、配線 (接続配線) で繋がれており、入出力端子311にはFPC310を異方性導電材で接着する。異方性導電材は樹脂と表面にAuなどがメッキされた数十〜数百 μm 径の導電性粒子から成り、導電性粒子により入出力端子とFPCに形成された配線とが電気的に接続される。メモリ、CPU、コントローラ、D/Aコンバータ等を備えたICチップも同様に異方性導電材で基板に接着し、樹脂中に混入された導電性粒子により、ICチップに設けられた入出力端子と引出線または接続配線及び入出力端子と電気的に接続する。

【0117】次いで、基板300を物理的手段により引き剥がすために被剥離層を固定する支持体 (プラスチック基板からなるカバー材) 309をエポキシ樹脂などの接着層308で貼りつける。(図6(C))ここでは、被剥離層の機械的強度が不十分であると仮定した例を示しているが、被剥離層の機械的強度が十分である場合には、被剥離層を固定する支持体なしで剥離することもできる。FPC310やICチップを覆って支持体309を貼り付けるため、支持体309の接着により、入出力端子311とFPCとの接続をさらに固定することができる。また、ここではFPCやICチップを接着した後、支持体を接着した例を示したが、支持体を接着した後、FPCやICチップを装着してもよい。

【0118】次いで、第1の材料層301が設けられている基板300を物理的手段により引き剥がす。第2の材料層302の膜応力と、第1の材料層301の膜応力が異なっているため、比較的小さな力で引き剥がすことができる。第1の材料層301と第2の材料層302との結合力は、熱エネルギーには耐え得る強さを有している一方、互いの膜応力は異なり、第1の材料層301と第2の材料層302との間には応力歪みを有しているため、力学的エネルギーに弱く、剥離するには最適である。こうして、第2の材料層302上に形成された被剥離層を基板300から分離することができる。剥離後の状態を図7(A)に示す。なお、この剥離方法は、小さな面積を有する被剥離層の剥離だけでなく、大きな面積を有する被剥離層を全面に渡って歩留まりよく剥離することが可能である。

【0119】次いで、第2の材料層302をエポキシ樹脂などの接着層308により転写体312aに貼り付け

る。実施の形態では、カバー材と保護膜との間に空隙を有する例を示したが、本実施例では保護膜307に接着層を接着した例を示す。

【0120】また、ここでは、転写体312aをプラスチックフィルム基板とすることで、軽量化を図っている。また、転写体312a上にバリア膜として機能する Al_xNy で示される層 (Al_xNy 膜とも呼ぶ) 312bと、応力緩和膜 (有機樹脂) 312cと、 Al_xNy 膜312dとの積層を設けて、バリア膜で水分や酸素などの不純物が有機発光層に入り込むのを効果的に防ぐとともに、複数のバリア膜の間に応力緩和膜を設けることによって、よりフレキシブルな発光装置になり、曲げたときのクラックを防ぐことができる。

【0121】このようにしてフレキシブルなプラスチック基板上に形成されたOLEDを有する発光装置が完成する。

【0122】なお、本明細書中において、転写体とは、剥離された後、被剥離層と接着させるものであり、特に限定されず、プラスチック、ガラス、金属、セラミックス等、いかなる組成の基材でもよい。また、本明細書中において、支持体とは、物理的手段により剥離する際に被剥離層と接着するためのものであり、特に限定されず、プラスチック、ガラス、金属、セラミックス等、いかなる組成の基材でもよい。また、転写体の形状および支持体の形状も特に限定されず、平面を有するもの、曲面を有するもの、可曲性を有するもの、フィルム状のものであってもよい。また、軽量化を最優先するのであれば、フィルム状のプラスチック基板、例えば、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリエーテルスルホン (PES)、ポリエチレンナフタレート (PEN)、ポリカーボネート (PC)、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリスルホン (PSF)、ポリエーテルイミド (PEI)、ポリアリレート (PAR)、ポリブチレンテレフタレート (PBT) などのプラスチック基板が好ましい。

【0123】〔実施例4〕本実施例では、画素電極を陽極とし、有機化合物層と陰極を積層して実施の形態 (図1) とは逆方向に発光する構成の一例を図8に示す。なお、上面図は図1と同一であるので省略する。

【0124】図8に示した断面構造について以下に説明する。 Al_xNy 膜1000bと応力緩和膜1000cと、 Al_2O_3 膜1000dとの積層が設けられたフィルム基板1000aが絶縁膜1001と接着層1023で貼り合わされている。

【0125】本実施例では、発光素子に距離が近い側に Al_xNy 膜1000bを設け、発光素子の発熱を発散するとともに、発光素子からの光を効率よく通過させるため、バリア膜として Al_xNy 膜よりも透光性の高い Al_2O_3 膜1000dを用いる。このようにバリア膜を Al_xNy で示される層と、応力緩和膜1000cと、 Al_2

○3で示される層との積層とした場合、フレキシブルな発光装置とすることができ、水分、酸素、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物をブロッキングすることができる効果に加え、熱伝導性が高く放熱効果を有し、さらには透光性が非常に高いという特徴を有している。

【0126】絶縁膜1001上には絶縁膜1010が設けられ、絶縁膜1010の上方には画素部1002、ゲート側駆動回路1003が形成されており、画素部1002は電流制御用TFT1011とそのドレインに電気的に接続された画素電極1012を含む複数の画素により形成される。電流制御用TFT1011は、nチャネル型TFTを用いることも可能であるが、pチャネル型TFTを用いることが好ましい。また、ゲート側駆動回路1003はnチャネル型TFT1013とpチャネル型TFT1014とを組み合わせたCMOS回路を用いて形成される。

【0127】これらのTFT(1011、1013、1014を含む)は、上記実施例1のnチャネル型TFT201、上記実施例1のpチャネル型TFT202に従って作製すればよい。

【0128】画素電極1012は発光素子(OLED)の陽極として機能する。また、画素電極1012の両端にはバンク1015が形成され、画素電極1012上には有機化合物層1016および発光素子の陰極1017が形成される。

【0129】陰極1017は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線1008を経由してFPC1009に電気的に接続されている。さらに、画素部1002及びゲート側駆動回路1003に含まれる素子は全て陰極1017、有機樹脂1018、及び保護膜1019で覆われている。保護膜1019として、1000bと同じAl_xNy膜を用いてもよい。また、カバー材1020と接着層で貼り合わせている。また、カバー材には凹部を設け、乾燥剤1021を設置する。

【0130】また、カバー材1020を図8に示す凹部形状とした場合、支持体となるカバー材1020を接着した後、剥離する際には配線引き出し端子の部分が絶縁膜1010のみとなり機械強度が弱くなるため、剥離前にFPC1009を貼り付け、さらに有機樹脂1022で固定することが望ましい。

【0131】また、図8では、画素電極を陽極とし、有機化合物層と陰極を積層したため、発光方向は図8に示す矢印の方向となっている。

【0132】また、ここではトップゲート型TFTを例として説明したが、TFT構造に関係なく本発明を適用することが可能であり、例えばボトムゲート型(逆スタガ型)TFTや順スタガ型TFTに適用することが可能である。

【0133】【実施例5】また、実施の形態ではトップ

ゲート型TFTを用いた例を示したが、ボトムゲート型TFTを用いることも可能である。ここではボトムゲート型TFTを用いた例を図9に示す。

【0134】図9中に示したようにnチャネル型TFT1113、pチャネル型TFT1114、nチャネル型TFT1111を全てボトムゲート構造とする。これらのボトムゲート構造は、公知の技術を用いて作製すればよい。なお、これらのTFTの活性層は、結晶構造を有する半導体膜(ポリシリコン等)であってもよいし、非晶質構造を有する半導体膜(アモルファスシリコン等)であってもよい。

【0135】また、図9中、1100aは、可撓性を有するフィルム基板(例えば、プラスチック基板等)、1100b、1100dはAl_xNy膜、1100cは、応力緩和膜(有機樹脂)、1101は、第2の材料層(例えば、酸化シリコン膜)である絶縁膜、1102は画素部、1103はゲート側駆動回路、1110は絶縁膜、1112は画素電極(陰極)、1115はバンク、1116は有機化合物層、1117は陽極、1118は有機樹脂、1119は保護膜(Al_xNy膜)、1120はカバー材、1121は乾燥剤、1122は有機樹脂、1123は接着層である。

【0136】また、nチャネル型TFT1113、pチャネル型TFT1114、nチャネル型TFT1111以外の構成は、実施の形態と同一であるのでここでは説明を省略する。

【0137】【実施例6】本実施例では、実施例3とバリア膜と応力緩和膜との組み合わせなどが異なる一例を図14に示す。

【0138】図14に示した断面構造について以下に説明する。OLED1205で示す発光素子から距離が近い順にAl_xNy膜1212eと、Al₂O₃膜1212dと、応力緩和膜1212cと、Al₂O₃膜1212dとの積層が設けられたフィルム基板1212aが絶縁膜と接着層1208で貼り合わせられている。

【0139】本実施例では、バリア膜を2層とすることを特徴としており、発光素子に距離が近い側にAl_xNy膜1212eを設け、発光素子の発熱を発散するとともに、発光素子からの光を効率よく通過させるため、バリア膜の2層目としてAl_xNy膜よりも成膜速度の速いAl₂O₃膜1212dを用いる。

【0140】このようにバリア膜をAl_xNyで示される層と、該層に接するAl₂O₃で示される層との積層とした場合、トータルの膜厚を薄くすることができ、水分、酸素、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物をブロッキングすることができる効果に加え、熱伝導性が高く放熱効果を有し、さらには透光性が非常に高いという特徴を有している。

【0141】絶縁膜の上方には画素部1214と、駆動回路1213の一部であるゲート側駆動回路とが形成さ

れており、画素部 1214 は電流制御用 T F T とそのドレインに電氣的に接続された画素電極を含む複数の画素により形成される。電流制御用 T F T は、n チャネル型 T F T を用いることも可能であるが、p チャネル型 T F T を用いることが好ましい。また、ゲート側駆動回路は n チャネル型 T F T と p チャネル型 T F T とを組み合わせた CMOS 回路を用いて形成される。

【0142】これらの T F T は、上記実施例 1 の n チャネル型 T F T 201、上記実施例 1 の p チャネル型 T F T 202 に従って作製すればよい。

【0143】画素電極は発光素子 (O L E D 1205) の陽極として機能する。また、画素電極の両端にはバンクが形成され、画素電極上には有機化合物層および発光素子の陰極が形成される。

【0144】陰極は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線を経由して F P C 1210 に電氣的に接続されている。さらに、画素部 1214 及びゲート側駆動回路に含まれる素子は全て陰極、有機樹脂からなる層間絶縁膜 1206、及び保護膜 1207 で覆われている。保護膜 1207 として、1212e と同じ Al_xNy 膜を用いてもよい。ここまでの工程は、上記実施例 3 及び実施例 4 に従って作製すればよい。

【0145】また、カバー材 1209a と接着層 1208 で貼り合わせている。また、カバー材 1209a には、有機樹脂からなる応力緩和膜 1209b、 Al_xNy 膜 1209c が設けられている。また、本実施例では、O L E D 1205 とカバー材 1209a との間に、発光素子に距離に近い順に、有機樹脂からなる層間絶縁膜 1206 と、 Al_xNy 膜 1207 と、有機樹脂からなる接着層 1208 と、 Al_xNy 膜 1209c と、有機樹脂からなる応力緩和膜 1209b とが設けられている。有機樹脂からなる層間絶縁膜や接着層も応力緩和膜としての機能を果たすことができる。即ち、 Al_xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層からなるバリア膜を 2 層以上設けて、さらに該 2 層のバリア膜の間に樹脂を含む応力緩和膜が設けられる構成となる。従って、バリア膜と応力緩和膜の積層により、発光装置全体としてフレキシブルとなる。

【0146】また、図 14 では、画素電極を陽極とし、有機化合物層と陰極を積層したため、発光方向は転写体 (フィルム基板) 1212a を通過する方向となっている。本実施例では、O L E D からの発光が通過する基板には透光性の高い Al_2O_3 で示される層をバリア膜として主に使用している。

【0147】また、本実施例は、実施例 1 乃至 5 のいずれか一と自由に組み合わせることができる。

【0148】〔実施例 7〕本発明を実施して形成された E L モジュールは様々な電子機器の表示部に用いることができる。即ち、E L モジュールを表示部に組み込んだ電子機器全てに本発明を実施できる。

【0149】その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ヘッドマウントディスプレイ (ゴーグル型ディスプレイ)、カーナビゲーション、プロジェクタ、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末 (モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等) などが挙げられる。それらの一例を図 10、図 11 に示す。

【0150】図 10 (A) はパーソナルコンピュータであり、本体 2001、画像入力部 2002、表示部 2003、キーボード 2004 等を含む。本発明を表示部 2003 に適用することができる。

【0151】図 10 (B) はビデオカメラであり、本体 2101、表示部 2102、音声入力部 2103、操作スイッチ 2104、バッテリー 2105、受像部 2106 等を含む。本発明を表示部 2102 に適用することができる。

【0152】図 10 (C) はモバイルコンピュータ (モバイルコンピュータ) であり、本体 2201、カメラ部 2202、受像部 2203、操作スイッチ 2204、表示部 2205 等を含む。本発明は表示部 2205 に適用できる。

【0153】図 10 (D) はゴーグル型ディスプレイであり、本体 2301、表示部 2302、アーム部 2303 等を含む。本発明は表示部 2302 に適用することができる。

【0154】図 10 (E) はプログラムを記録した記録媒体 (以下、記録媒体と呼ぶ) を用いるプレーヤーであり、本体 2401、表示部 2402、スピーカ部 2403、記録媒体 2404、操作スイッチ 2405 等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体として DVD (Digital Versatile Disc)、CD 等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示部 2402 に適用することができる。

【0155】図 10 (F) はデジタルカメラであり、本体 2501、表示部 2502、接眼部 2503、操作スイッチ 2504、受像部 (図示しない) 等を含む。本発明を表示部 2502 に適用することができる。

【0156】図 11 (A) は携帯電話であり、本体 2901、音声出力部 2902、音声入力部 2903、表示部 2904、操作スイッチ 2905、アンテナ 2906、画像入力部 (CCD、イメージセンサ等) 2907 等を含む。本発明を表示部 2904 に適用することができる。

【0157】図 11 (B) は携帯書籍 (電子書籍) であり、本体 3001、表示部 3002、3003、記憶媒体 3004、操作スイッチ 3005、アンテナ 3006 等を含む。本発明は表示部 3002、3003 に適用することができる。

【0158】図 11 (C) はディスプレイであり、本体

3101、支持台3102、表示部3103等を含む。本発明は表示部3103に適用することができる。

【0159】ちなみに図11(C)に示すディスプレイは中小型または大型のもの、例えば5〜20インチの画面サイズのものである。また、このようなサイズの表示部を形成するためには、基板の一边が1mのものを用い、多面取りを行って量産することが好ましい。

【0160】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器の作製方法に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例1〜6のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

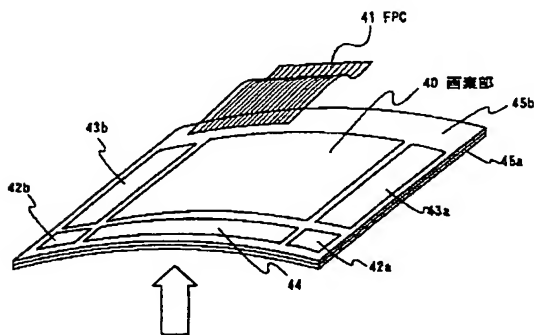
【0161】

【発明の効果】本発明のバリア膜(Al_xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層)を複数積層することで、バリア膜にクラックが生じて、他のバリア膜で水分や酸素などの不純物の有機発光層への混入を効果的に防ぐことができる。また、本発明のバリア膜(Al_xNy で示される層)により、素子の発熱を拡散させて素子の劣化を抑える効果とともに、プラスチック基板の変形や変質を保護する効果を有する。

【0162】また、本発明において、発光素子からの発光が通過するバリア膜の一層として Al_2O_3 で示される層を用いた場合、透光性が高く、発光素子からの発光の妨げにならない。

【0163】加えて、本発明のバリア膜(Al_xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層)は、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物のTFTの活性層及び有機発光層への混入を効果的に防ぐことができる。

【図2】



【0164】また、本発明のバリア膜(Al_xNy で示される層または Al_2O_3 で示される層)に比べて応力が小さい応力緩和膜を、複数のバリア膜の間に挟むことで、絶縁膜全体の応力を緩和することができる。よって、外力が与えられても破壊することなく、フレキシブルな発光装置とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 ELモジュールの上面図および断面図。

【図2】 外力が加わったときのELモジュールの外観図。

【図3】 TFTの作製工程を示す図。

【図4】 TFTの作製工程を示す図。

【図5】 OLEDが設けられたアクティブマトリクス基板の断面図。

【図6】 実施例3を説明する工程断面図。

【図7】 実施例3を説明する工程断面図。

【図8】 実施例4を説明するELモジュールの断面図。

【図9】 実施例5を説明するELモジュールの断面図。

【図10】 電子機器の一例を示す図。

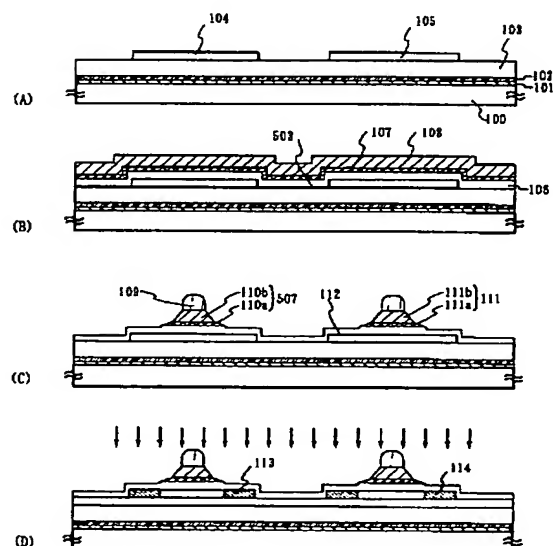
【図11】 電子機器の一例を示す図。

【図12】 本発明の Al_xNy 膜の透過率を示すグラフである。

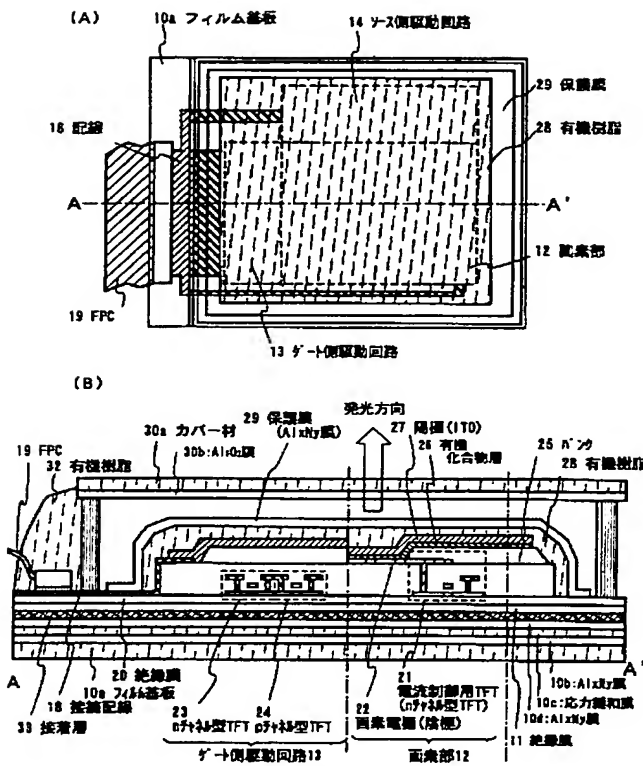
【図13】 本発明の Al_xNy 膜のESCA分析結果である。

【図14】 実施例6を説明するELモジュールの断面図。

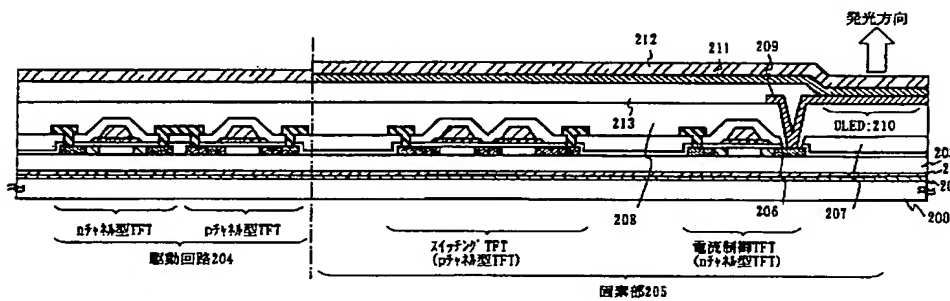
【図3】



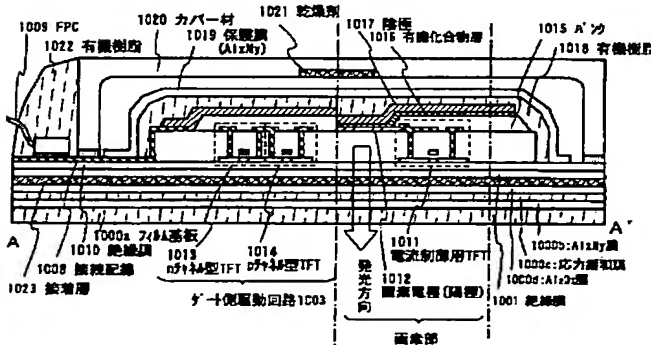
【図1】



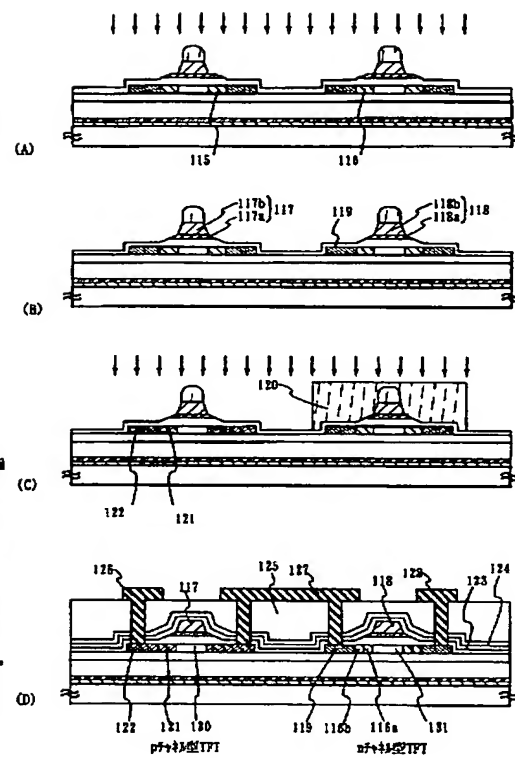
【図5】



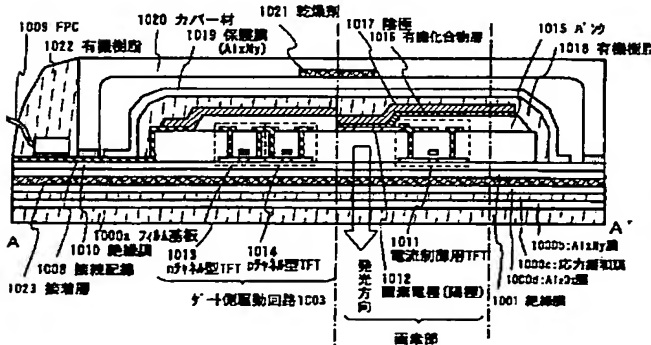
【図8】



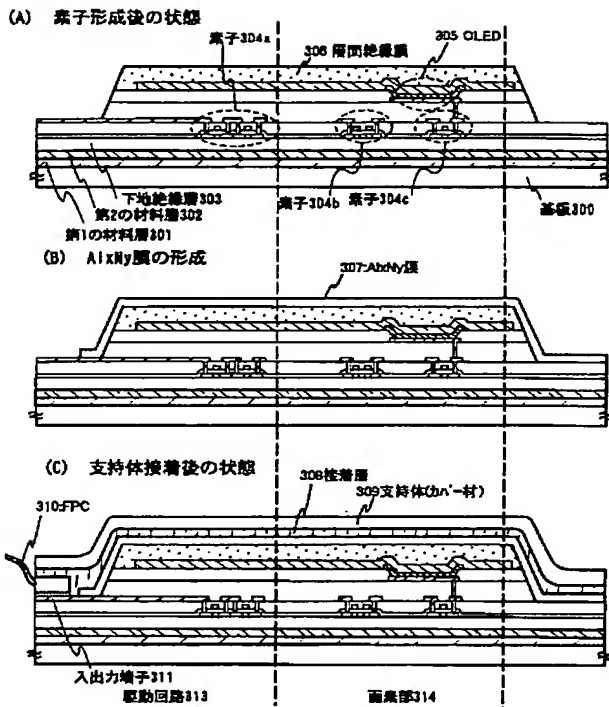
【図4】



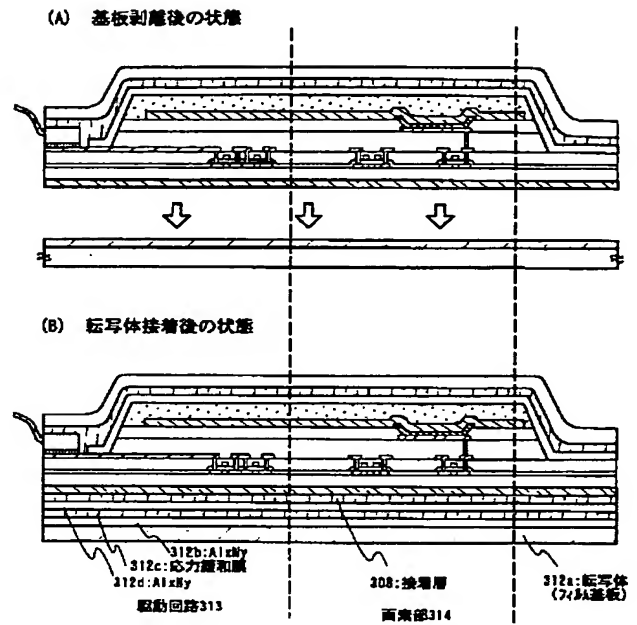
【図9】



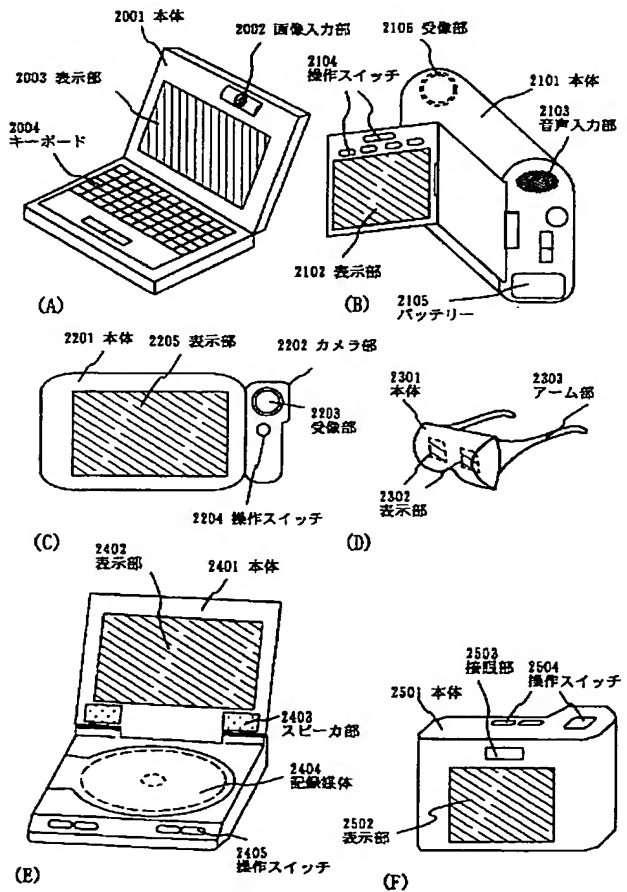
【図6】



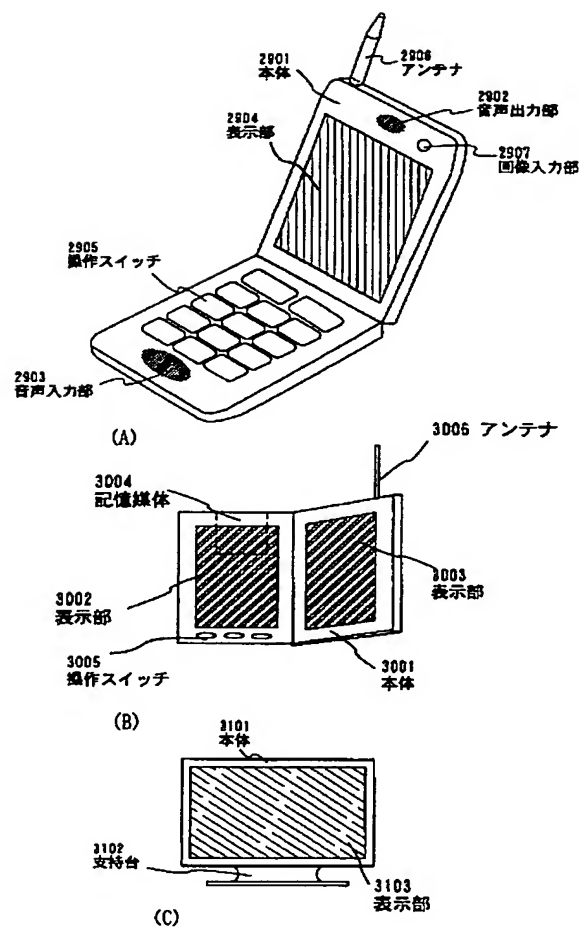
【図7】



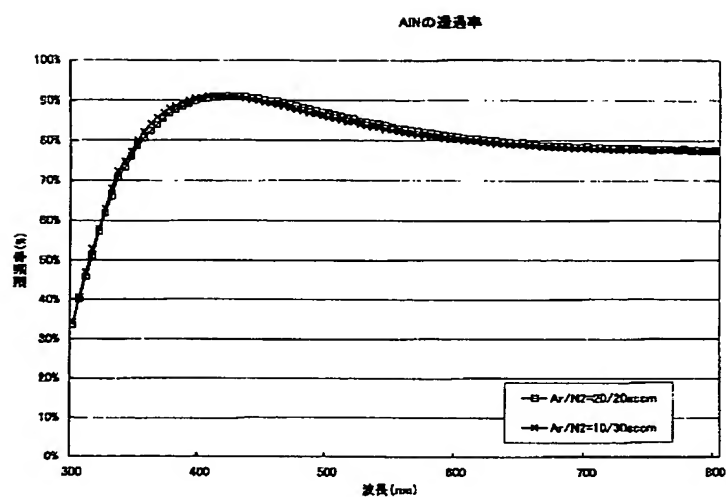
【図10】



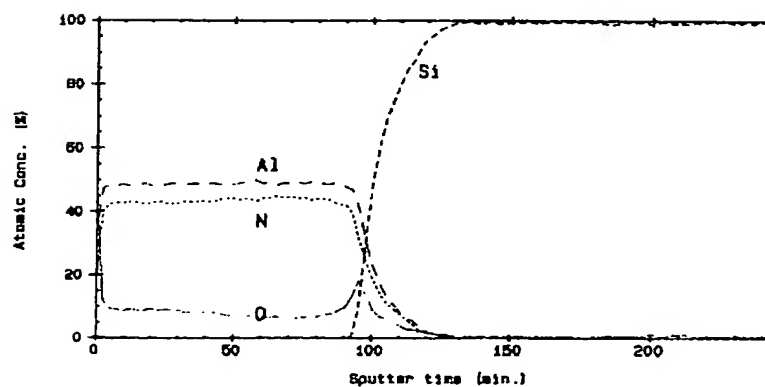
【図11】



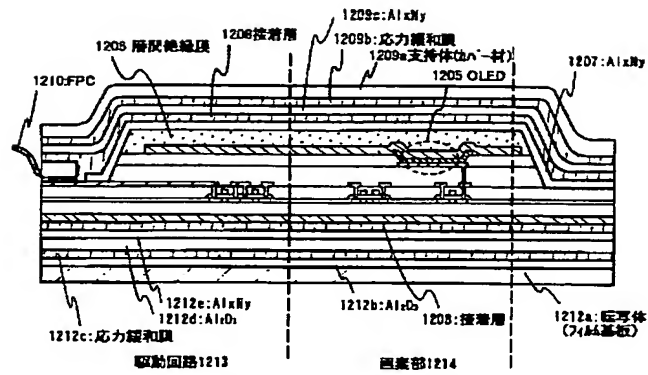
【図12】



【図13】



【図 14】



フロントページの続き

Fターム(参考) 3K007 AB13 AB14 BA06 BA07 CA00
 CA05 CA06 CB01 DA00 DB03
 EB00 FA01 FA02 FA03
 5C094 AA31 AA36 BA27 DA13 DA15
 FB01

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.